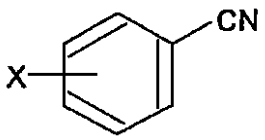
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成23年10月13日(2011.10.13)

【公表番号】特表2008-521852(P2008-521852A)
【公表日】平成20年6月26日(2008.6.26)
【年通号数】公開・登録公報2008-025
【出願番号】特願2007-543762(P2007-543762)
【国際特許分類】
Ｃ０７Ｃ 253/22 (2006.01)
Ｂ０１Ｊ 27/18 (2006.01)
Ｂ０１Ｊ 35/10 (2006.01)
Ｂ０１Ｊ 37/08 (2006.01)
Ｃ０７Ｃ 255/53 (2006.01)
Ｃ０７Ｃ 255/58 (2006.01)
Ｃ０７Ｃ 253/34 (2006.01)
Ｃ０７Ｂ 61/00 (2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０７Ｃ 253/22
Ｂ０１Ｊ 27/18 Ｚ
Ｂ０１Ｊ 35/10 ３０１Ｊ
Ｂ０１Ｊ 35/10 ３０１Ｇ
Ｂ０１Ｊ 37/08
Ｃ０７Ｃ 255/53
Ｃ０７Ｃ 255/58
Ｃ０７Ｃ 253/34
Ｃ０７Ｂ 61/00 ３００

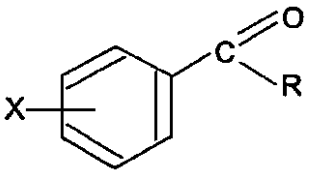
【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年8月29日(2011.8.29)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式（Ｉ）：
【化１】



(I)

（式中、Ｘは少なくとも１個のアミノ基またはヒドロキシ基を表す）のアミノ－またはヒドロキシベンゾニトリルを製造する方法であり、一般式（ＩＩ）：

【化２】



(II)

（式中、Ｒは－ＯＨ、－ＮＨ$_2$であり、Ｘは前記のものを表す）のアミノ－またはヒドロキシ安息香酸化合物を、燐含有担体触媒の存在で２５０～５００℃の温度で、アンモニアと反応させることによりアミノ－またはヒドロキシベンゾニトリルを製造する方法において、製造工程１）を反応ガス（混合物）中で、有機溶剤を関与せずに実施し、引き続き少なくとも２段階の精製工程２）を実施し、その際２．１）製造工程１）から得られるガス状混合物または固体の反応生成物を水性アンモニウム含有懸濁液に変換し、２．２）
ａ）固体中にアンモニウム塩として存在する生成物の遊離を、酸を添加する濾過によりまたはアンモニアの追い出しおよび引き続く酸成分の導入により行うか、または
ｂ）固体中にアンモニウム塩として存在する生成物の遊離を、反応蒸留により行うか、または
ｃ）固体中にアンモニウム塩として存在する生成物の遊離を、０～１００℃の温度で、有機溶剤の存在での分離によって行うことを特徴とするアミノ－またはヒドロキシベンゾニトリルを製造する方法。

【請求項２】
前記方法を３４０～４５０℃の温度で実施する請求項１記載の方法。

【請求項３】
前記温度が３８０～４２０℃である請求項２記載の方法。

【請求項４】
触媒が元素周期表の５、６，１２および１４族の遷移金属化合物またはその組合せ物でドープされ、比表面積が少なくとも３００ｍ^2／ｇである請求項１から３までのいずれか１項記載の方法。

【請求項５】
付加的に硼素でドープされた担体触媒を使用する請求項１から４までのいずれか１項記載の方法。

【請求項６】
燐酸０．０１～１５質量％、ホウ酸０．０１～１５質量％および元素周期表の５，６，１２または１４族の遷移金属の塩または前記塩の組合せ物０．０１～５質量％の水溶液を使用する担体材料の処理により製造された燐酸硼素担体触媒を使用する請求項１から５までのいずれか１項記載の方法。

【請求項７】
担体材料が二酸化珪素、シリカゲル、酸化アルミニウム、酸化チタン、または酸化ジルコンもしくはその混合物からなる請求項１から６までのいずれか１項記載の方法。

【請求項８】
触媒を、バナジウム、ニオブ、タンタル、クロム、モリブデン、タングステン、カドミウム、水銀、ゲルマニウム、錫、鉛、または亜鉛の元素の塩もしくはこれらの塩の組合せ物でドープする請求項１から７までのいずれか１項記載の方法。

【請求項９】
塩がそれぞれの元素のカチオンおよびホウ酸アニオン、塩化物アニオン、燐酸アニオンまたは硫酸アニオンからなる請求項８記載の方法。

【請求項１０】
塩がそれぞれの元素のアニオンおよびカチオンとしてアンモニウムからなる請求項８記載の方法。

【請求項１１】
ドープされた担体触媒の比表面積が４００ｍ^2／ｇより大きい請求項１から１０までの

いずれか１項記載の方法。
【請求項１２】
前記比表面積が５００ｍ^2／ｇより大きい請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
前記比表面積が６００ｍ^2／ｇより大きい請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
前記比表面積が７５０ｍ^2／ｇより大きい請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
ドープされた燐酸硼素担体触媒が０．４～２５ｎｍの細孔直径を有する請求項１から１４までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１６】
前記細孔直径が０．５～１５ｎｍである請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
ドープされた担体触媒を１００～５００℃の温度で３時間まで乾燥する請求項１から１６までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１８】
反応ガス（混合物）が酸素不含であり、アンモニアを含有する請求項１から１７までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１９】
アミノ－またはヒドロキシ安息香酸化合物を反応ガス（混合物）および／または触媒床に導入する請求項１から１８までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２０】
前記導入をアンモニウム塩の溶融物、固体または水溶液として行う請求項１９記載の方法。
【請求項２１】
精製工程２）を－２０℃～１００℃の温度で実施する請求項１から２０までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２２】
前記温度が０℃～６０℃である請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
前記温度が２℃～７℃である請求項２２記載の方法。
【請求項２４】
精製工程２）を不活性ガス条件下で実施する請求項１から２３までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２５】
精製工程２）を窒素雰囲気で実施する請求項２４記載の方法。
【請求項２６】
精製工程２）において水またはアンモニア水を使用して実施するクエンチにより水性アンモニウム含有懸濁液を取得する請求項１から２５までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２７】
精製工程２）において製造工程１）から得られる生成物の冷却および引き続くアンモニア水の取り入れにより水性アンモニウム含有懸濁液を取得する請求項１から２５までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２８】
水性アンモニウム含有懸濁液が高度に濃縮した形で存在し、副生成物を溶解した形で含有する請求項１から２７までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２９】
酸の添加によりまたは酸性ガスの導入により酸性条件を調節する請求項１から２８までのいずれか１項記載の方法。
【請求項３０】

無機酸の添加によりまたはCO_2の導入により酸性条件を調節する請求項２９記載の方法。

【請求項３１】

無機酸が塩酸である請求項３０記載の方法。

【請求項３２】

引き続き少なくとも１つの洗浄工程および少なくとも１つの乾燥工程を行う請求項１から３１までのいずれか１項記載の方法。